

	<p><b>SI2309CDS-T1-GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI2309CDS-T1-GE3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 60V 1.6A SOT23-3</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI2309CDS-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 95933 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI2309CDS-T1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 1.6A SOT23-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	95933 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	1W (Ta), 1.7W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	345 mOhm @ 1.25A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4.1nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	210pF @ 30V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
















SI2309CDS-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI2309CDS-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI2309CDS-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI2309CDS-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI2309CDS-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 1.6A SOT23-3</p>	 <p><b>SI2309ADS-T1-GE3</b> V V TO-236</p>	 <p><b>SI2309CDS-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 1.6A SOT23-3</p>	 <p><b>SI2309DS-T1</b> VISHAY SI2309DS-T1 VISHAY</p>
 <p><b>SI2309DS-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 1.25A SOT23-3</p>	 <p><b>SI2309CDS-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 1.6A SOT23-3</p>	 <p><b>SI2309BDS-T1-E3</b> V SI2309BDS-T1-E3 V</p>	 <p><b>SI2309DS-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 1.25A SOT23-3</p>

### heiße Teile

Mehr

 SI2307BDS-T1-GE3	 SI2307BDS-T1-GE3	 SI2307CDS	 SI2307CDS-T1-E3	 SI2307CDS-T1-E3
 SI2307CDS-T1-GE3	 SI2307CDS-T1-GE3	 SI2307DS	 SI2307DS-T1	 SI2307DS-T1-E3
 SI2307DS-T1-GE3	 SI2307DS-T7-E3	 SI2308BDS	 SI2308BDS-T1-E3	 SI2308BDS-T1-E3
 SI2308BDS-T1-GE3	 SI2308BDS-T1-GE3	 SI2308DS	 SI2308DS-T1	 SI2308DS-T1-E3
 SI2308DS-T1-E3	 SI2308DS-T1-GE3	 SI2309BDS-T1-E3	 SI2309BDS-T1-GE3	 SI2309CDS-T1-GE3
 SI2309DS	 SI2309DS-T1	 SI2309DS-T1-E3	 SI2309DS-T1-E3	 SI2309DS-T1-GE3
 SI2309DS-T1-E3	 SI2309DS/A92T	 SI2310DS	 SI2310DS-T1-E3	 SI2310DS-T1-GE3
 SI2311DS	 SI2311DS-T1	 SI2311DS-T1-E3	 SI2311DS-T1-E3	 SI2311DS-T1-GE3
 SI2311DS-T1-GE3	 SI2312BDS	 SI2312BDS-T1-E3	 SI2312BDS-T1-E3	 SI2312BDS-T1-GE3
 SI2312BDS-T1-GE3	 SI2312CDS-T1-E3	 SI2312CDS-T1-GE3	 SI2312CDS-T1-GE3	 SI2312DS

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited